

نام و نام خانوادگی:

دیبرستان:

شماره صندلی:

پاسمه تعالی

مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۸

گروههای آموزشی

آزمون هماهنگ منطقه‌ای - درس فیزیک سوم ریاضی

سوالات	ردیف	بارم
۱ جملات زیر را با انتخاب کلمه یا کلمات مناسب پر کنید. الف- در یک فرایند همدمان انرژی درونی ..... است. ب- اختلاف پتانسیل دو سر خازنی را دو برابر می کنیم. ظرفیت خازن ..... داشته باشد. ج- آمپرسنج در صورتی ایده آل است و دقت مناسبی دارد که ..... داشته باشد. د- به دستگاهی که برای تنظیم حریان در مدار مورد استفاده قرار می گیرد ..... گفته می شود. س- یکی از عوامل مؤثر بر مقاومت ویژه ..... می باشد. و- اگر ذره باردار عمود بر سطح پیچه و از مرکز پیچه عبور کند، نیروی الکترو مغناطیسی وارد بر آن ..... می باشد. ی- هر چه شار مغناطیسی در یک پیچه آهسته تغییر کند، نیروی محركه القائی ..... در حلقه ایجاد خواهد شد.	۱	۱/۷۵
۲ به این پرسشها پاسخ دهید: الف- وجود برفک روی بدنه داخلی محفظه‌ی بخ ساز بخجال چه تأثیری بر عملکرد دستگاه دارد؟ توضیح دهید. ب- در انساط بی دررو، دمای گاز کامل چه تغییری می کند؟ با استفاده از روابط با توضیح کافی پاسخ دهید. ج- اگر دمای چشمی گرم و سرد را به یک اندازه کاهش دهیم بازده ماشین گرمائی کارنو چگونه تغییر می کند؟ (توشن روابط الزامی است)	۲	۰/۱۵
۳ در یک فرایند خاص یک گاز کامل تک اتمی $200\text{ Zول}$ گرما از دست داده و $80\text{ Zول}$ کار توسط محیط بر دستگاه انجام می گیرد. تغییر انرژی درونی گاز کامل را در این فرایند محاسبه نموده، نوع فرآیند را با ذکر دلیل مشخص کنید.	۳	۰/۷۵
۴ مقدار $1/2\text{ مول}$ گاز کامل نک اتمی، چرخه‌ای را مطابق شکل می بیماید. تعیین کنید: الف- دمای گاز در حالت A ب- گرمای مبادله شده در چرخه AB ب- کار انجام شده در فرآیند AB $C_{MP} = \frac{5}{2} R \quad C_{MV} = \frac{3}{2} R \quad R = 8 \text{ J/mol}^{\circ}\text{K}$	۴	۰/۱۵
۵ به سوالات زیر پاسخ دهید: الف- عوامل مؤثر بر میدان الکتریکی در یک نقطه را نام ببرید. ب- یک کره فلزی باردار را که روی پایه نارسانانی قرار دارد به آنگ بدون بار الکتریکی که از یک نقطه آویزان است نزدیک می کنیم. با رسم شکل توضیح دهید چه اتفاقی می افتد.	۵	۰/۷۵
۶ میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی نقاط A و B را باهم مقایسه کنید. اگر بار الکتریکی $-q$ در نقاط A و B قرار گیرد، انرژی پتانسیل الکتریکی بار $-q$ در کدام نقطه بیشتر خواهد بود؟ چرا؟	۶	۰/۱۵
۷ $30\text{ میلیمتر}$ بار الکتریکی به کره رسانانی به شعاع $2\text{ cm}$ می دهیم. چگالی سطحی بار الکتریکی کره $6$ برابر می شود. چگالی بار سطحی اولیه کره رسانا چه مقدار بوده است. ( $\pi=3$ فرض شود)	۷	۱
۸ در مدار مقابل سه خازن $C_1=12\mu\text{F}$ $C_2=3\mu\text{F}$ $C_3=4\mu\text{F}$ قرار دارند. هریک از این خازنها می توانند حداکثر $120\text{ ولت}$ را تحمل کنند. حداکثر ولتاژ قابل تحمل این مجموعه را برای آنکه هیچ یک از خازنها آسیب نسبینند را تعیین کنید.	۸	۱

۱	<p><math>2m</math></p>	<p>سه بار الکتریکی مطابق شکل مقابل در سه رأس یک مثلث متساوی الاضلاع قرار دارد.</p> <p>اگر نیروی برآیند الکتریکی وارد بر بار ۱ برابر <math>q_1 = 18 \times 10^{-7}</math> نیوتون باشد، اندازه و نوع بار ۱ را تعیین کنید.</p> <p><math>q_2 = -4\mu C</math>    <math>q_3 = +4\mu C</math>    <math>k = 9 \times 10^9 \text{ NM}^2/\text{C}^2</math></p>	۹
۱۰		<p>به سؤالات زیر پاسخ دهید:</p> <p>الف- دانش آموزی مقاومت رشته سیم داخل لامپ ۱۰۰ وات و ۲۲۰ ولتی را با اهم سنج اندازه گیری کرده و مقدار آن را <math>\frac{48}{4}</math> اهم بدست آورده است. دانش آموز دیگری مقاومت را از رابطه <math>P = \frac{V^2}{R}</math> محاسبه نموده و عدد ۴۸۴ اهم را بدست آورده است. توضیح دهید</p> <p>علت تفاوت مقدارها در دو حالت چیست؟</p> <p>ب- با توجه به نمودار مقابل که مربوط به دو مولد A و B می باشد، مقاومت درونی آنها را با ذکر دلیل مقایسه نمایید.</p>	۱۰
۱۱		<p>مدار مقابل قسمتی از یک مدار را نشان می دهد.</p> <p>تعیین کنید:</p> <p>الف- توان تولیدی مولد <math>\epsilon_1</math></p> <p>ب- انرژی مصرف شده در مقاومت <math>R_2</math> در مدت ۱۰۰ ثانیه</p> <p>ج- اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B</p>	۱۱
۱۲		<p>به سؤالات زیر پاسخ دهید:</p> <p>الف- ۲ ویزگی خطوط میدان مغناطیسی را بیان کنید.</p> <p>ب- تsla یکای میدان مغناطیسی را تعریف کنید.</p> <p>ج- آزمایشی طراحی کنید که به کمک آن بتوان نیروی الکترو مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی پیوسته را تعیین نمود.</p>	۱۲
۱۳	<p>سیم روکش داری به طول <math>25/12\pi</math> را به صورت پیچه ای به قطر <math>32</math> سانتی متر در آورده و از آن جریان <math>\pi</math> آمیر عبور می دهیم. سیم راستی را در کنار این پیچه مطابق شکل قرار می دهیم.</p> <p>اگر جریان عبوری از سیم راست <math>50</math> آمیر باشد؛ جهت جریان و فاصله سیم از مرکز پیچه چه قدر باشد تا میدان مغناطیسی برآیند در مرکز پیچه صفر شود. (سیم راست دیگر ریشه ندارد)</p> <p><math>\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TMA}</math></p>	<p>سیم روکش داری به طول <math>25/12\pi</math> را به صورت پیچه ای به قطر <math>32</math> سانتی متر در آورده و از آن جریان <math>\pi</math> آمیر عبور می دهیم. سیم راستی را در کنار این پیچه مطابق شکل قرار می دهیم.</p> <p>اگر جریان عبوری از سیم راست <math>50</math> آمیر باشد؛ جهت جریان و فاصله سیم از مرکز پیچه چه قدر باشد تا میدان مغناطیسی برآیند در مرکز پیچه صفر شود. (سیم راست دیگر ریشه ندارد)</p> <p><math>\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TMA}</math></p>	۱۳
۱۴	<p>سیمولوه ای مطابق شکل عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی که اندازه آن <math>4 \times 10^{-4}</math> تsla و جهت آن از راست به چپ می باشد قرار دارد. این سیمولوه <math>500</math> دور است. میدان مغناطیسی در مدت <math>10^{-4}</math> ثانیه تغییر کرده و به <math>10^{-4}</math> تsla در خلاف جهت اولیه می رسد. اگر سطح هر حلقه <math>50 \text{ cm}^2</math> باشد، اندازه نیرو محکم القائی متوسط در پیچه را حساب کنید. جهت جریان القائی در پیچه را نیز مشخص کنید.</p>	<p>سیمولوه ای مطابق شکل عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی که اندازه آن <math>4 \times 10^{-4}</math> تsla و جهت آن از راست به چپ می باشد قرار دارد. این سیمولوه <math>500</math> دور است. میدان مغناطیسی در مدت <math>10^{-4}</math> ثانیه تغییر کرده و به <math>10^{-4}</math> تsla در خلاف جهت اولیه می رسد. اگر سطح هر حلقه <math>50 \text{ cm}^2</math> باشد، اندازه نیرو محکم القائی متوسط در پیچه را حساب کنید. جهت جریان القائی در پیچه را نیز مشخص کنید.</p>	۱۴
۱۵	<p>قاب مستطیل شکل مقابل در صفحه کاغذ بطرف راست حرکت می کند.</p> <p>چرا در قاب جریان القائی ایجاد می شود؟</p> <p>جهت جریان القائی در قاب را مشخص کنید.</p>	<p>قاب مستطیل شکل مقابل در صفحه کاغذ بطرف راست حرکت می کند.</p> <p>چرا در قاب جریان القائی ایجاد می شود؟</p> <p>جهت جریان القائی در قاب را مشخص کنید.</p>	۱۵

## فیزیک: سوم ریاضی فیزیک

- ۱- الف) ثابت ب) ثابت می باشد ج- معاونت انتقالی بسیار لوچی د- روش  
 س) دما و صفر ی) کمتری (حرکت)  
 (حرکت)

۲- الف- پرینک مانند عالی عمل نموده و مانع از سادگی گرمای سیان هوار در زمان بخال و لوله هار مبرد خواهد شد  
 سیان گرمای کمتر نشده از راحل بخال ظاهض باقیه ضریب عملکرد ظاهض خواهد بایست (۵٪ غره)  
 ب- در زمانی که در رو  $Q = 0$  پرس تا زدن اول ترسود نباشد بصورت  $W = \infty$  خواهد بود چون  
 فرآیند ابساط است پس  $W = 0$  دیگر نگست.  $\infty$  خواهد بود چون افزودن گاز کامل فقط  
 تابع ریاضی مطلق است پس  $\infty$  خواهد بود و داد جعل کا همی است (۵٪ غره)

$$\eta_{max(1)} = 1 - \frac{\bar{T}_C}{T_H} = \frac{T_H - \bar{T}_C}{T_H} \quad (1/20)$$

$$\eta_{max(2)} = 1 - \frac{\bar{T}_C - \Delta T}{T_H - \Delta T} = \frac{T_H - \Delta T - \bar{T}_C + \Delta T}{T_H - \Delta T} = \frac{T_H - \bar{T}_C}{T_H - \Delta T} \quad (1/20)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{T_H - \bar{T}_C}{T_H} < \frac{T_H - \bar{T}_C}{T_H - \Delta T} \Rightarrow \eta_{max(1)} < \eta_{max(2)} \\ \end{array} \right. \quad (1/20)$$

با همین دمای بزرگ کارنو افزایش می طابد

$$Q = -20 \text{ J} \quad (1/20)$$

$$\Rightarrow \Delta U = Q + W = -10 \text{ J} \quad (1/20)$$

۳- چون  $Q$  و  $W$  علاوه علیه دارند  
 و  $|W| > |Q|$  پس مرآت هم منقار است (1/20)

$$(1/20) PAV_A = nRT_A \rightarrow 1,5 \times 1,0 \times 4 \times 1,0^{-3} = 1,2 \times 1,0 \text{ K} \quad (1/20)$$

۴- الف-

$$Q_{AB} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} = nC_m \nu \Delta T + nC_p m \Delta T = \frac{3}{4} nR \Delta T + \frac{5}{4} nR \Delta T \quad (1/20)$$

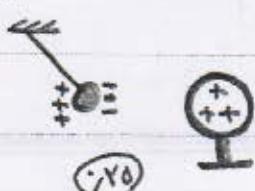
$$= \frac{3}{4} \nu \Delta P + \frac{5}{4} P \Delta V = \frac{3}{4} \times 1,0^{-3} (5 \times 1,0 - 1,5 \times 1,0) + \frac{5}{4} 1,5 \times 1,0 (4 \times 1,0 - 1 \times 1,0) = 2100 - 1500 = 600 \text{ J} \quad (1/20)$$

$$W_{AB} = W_V = \dots \quad (1/20)$$

ج

۵- الف- نحوه توزیع بار- اندازه بار- ناصله بار تا نقطه موردنظر (حرکت)  
 ب- کره مذکوی باردار باعث انتقال کمتری آزاد خواهد شد و باعث می شود که بارهای ناچنانم که

و آنکه معادله قرارگیریه همکنی را حذف کنند. (1/20)



فیزیک: سوم ریاضی نیز

۴- چون میدان الکتریکی نماینده است پس  $E_B = E_A$ (۱۷۰)  $U_B < U_A$  هرچه باره صفحه‌ی همان نزدیک‌تر باشد انرژی پتانسیل بستردارد.

$$U_A > U_B \sim U_A - U_B \rightarrow \Delta U_{AB} \rightarrow \frac{\Delta U_{AB}}{q} \rightarrow \Delta V_{AB} \Rightarrow U_A - U_B \Rightarrow V_A < V_B$$

$$\frac{G_r}{G_1} = \frac{q_r}{q_1} \rightarrow \frac{G_1}{G_1} = \frac{q_1 + r}{q_1} \Rightarrow q_1 = 2\mu C$$

$$G_1 = \frac{q_1}{A_1} = \frac{\pi r_1^2}{4\pi r_1^2} = \frac{\pi r_1^2}{12 \times (\pi r_1^2)^2} = \frac{1}{12r_1^2} \frac{C}{m^2}$$

$$q_1 = C_1 V_1 = 12 \times 12 = 144 \mu C$$

۱- با توجه به تغیر تقابل عالی‌تر برای مدار متولی

$$q_{r_f} = C_r V_f = 4 \times 12 = 48 \mu C$$

نمی‌تواند از  $36 \mu C$  بستردارد چون خازن

$$q_{r_f} = C_r V_f = 4 \times 12 = 48 \mu C$$

خواهد بود  $36 \mu C \leq q_{r_f}$  خواهد بود.

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_r} + \frac{1}{C_p} = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1+4+3}{12} = \frac{8}{12} \Rightarrow C_t = \frac{12}{8} = 1.5 \mu F$$

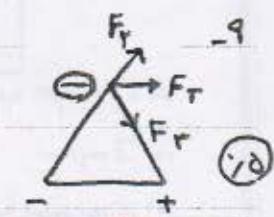
$$C_t = \frac{q_t}{V_t} \Rightarrow 1.5 = \frac{48}{V_t} \Rightarrow V_t = 32 \text{ Volt}$$

$$F_T = F \cos \frac{1}{r} \Rightarrow F_T = F \cos \gamma \Rightarrow F_T = F = \frac{k q_r q_1}{r^2} \Rightarrow 1.8 \times 1 = \frac{9 \times 1.5 \times 4 \times 12}{4^2}$$

(۱۷۰)

$$q_1 = 2\mu C$$

منفی است



۵-  $F = \frac{q^2}{R}$  اهم تفاوت، لامپ در حالت خاموش است که اهم سبب اندازه لبری کرده و لامپ می‌باشد که از رابطه بسته‌ی آن سریع‌تر تفاوت لامپ در حالت روشن است که لامپ کرم شده در محاله‌ی رفتہ تفاوت الکتریکی افزایشی دارد

$$I_B > I_A \Rightarrow \frac{E_B}{r_B} > \frac{E_A}{r_A} \xrightarrow{E_A = E_B} \frac{1}{r_B} > \frac{1}{r_A} \Rightarrow r_B < r_A$$

(۱۷۰)

فیزیک: سوم رایاضی نظری

الف)  $P_1 = \mathcal{E}_1 I_1 = 5 \times 2 = 10 \text{ W}$  (۱۷۰)

ب)  $W = I_r^2 R_r t = (10)^2 \times 4 \times 1 = 400 \text{ J}$  (۱۷۰)

ج)  $I_y = I_1 + I_2 \Rightarrow I_2 = 1,0 \text{ A}$

$$V_A + \mathcal{E}_1 - I_1 R_1 + I_2 R_2 + \mathcal{E}_3 + I_3 R_3 = V_B \rightarrow V_A + 0 - 2 \times 2 + 1,0 \times 1 + 4 + 3 \times 1,0 = V_B \rightarrow V_B - V_A = 13$$

(۱۷۰)

۱۲- الف- حدود تقریبی ۲۵٪ جمیع دستگاههای موزه

ج- آزمیش ۴-۴ دانشسیت محمد پا هزار سرمه در میتواند

-۱۳-

$$N = \frac{L}{R_1 R_2} = \frac{20,12}{2 \times 4,14 \times 1,14} = 25 \text{ دور}$$

طبقه ۶.

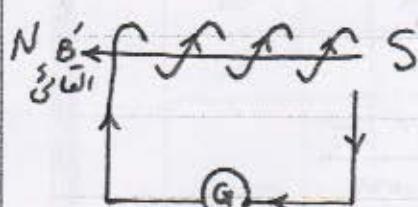
$$\text{کم راستاراندیده } B = B_{\text{پیش}} \theta$$

ایم جزوی در سیم لباقر باشد که میتواند

$$\frac{\mu_0 N I_1}{l} = \frac{\mu_0 I_r}{R_1} \Rightarrow \frac{NI_1}{R_1} = \frac{l}{R_1} I_r$$

مسوی از سیم راست و حلقة درون حلقه همکر را خواهد کند

$$\frac{20 \times 1}{1,17} = \frac{20}{1,17} \Rightarrow R_1 = 1,17 \text{ m} = 1 \text{ cm}$$



$$|\bar{E}| = |-N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}| = |-NA \cos \theta \frac{\Delta B}{\Delta t}|$$

$$|\bar{E}| = |-0,00005 \times 1,17^2 \cos 0| = \frac{-0,00005 \times 1,17^2}{0,1} = 20 \text{ V}$$

طبقی کانون نیز جهت جوان اتفاق نمیگزد ای است که با این اجراسیان مقابله میکنیم

اللائئی از راست به چپ با تغییرات شارطی میکنیم حاصل از تغییر  $B$  فی لفتی غاییر.

توجه: اگر بدین توضیح بارسم شکل جهت جوان اتفاق مخصوص کردیم نیزه کامل را داده میکرد

۱۴- با دروردن ناب از سیم خطوط میدان مقابله میکنیم که از آن بگذرد

تغییری کند پس شارطی میکنیم تغییر عورده بر طبقی کانون میدان در این آنکه

تغییری رفته میکنیم نیزه و میدان اتفاقی در مقابل اینکاری گردد (۱۷۰)

